

ПК «ЯДРО»

КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ПАРА КРЕМНИЕВЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ со СВЕРХМАЛЫМ ПРЯМЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Транзисторы предназначены для применения в переключательных, импульсных схемах с низким напряжением насыщения и другой аппаратуре.

Транзисторы соответствуют АДБК 432140.943 ТУ

Основные параметры

Параметр	Обозн.	КТ529А КТ530А	Единицы измерения
Обратный ток коллектора (Ucb=80 В)	Ic	1	МкА
Обратный ток эмиттера (Ueb=4 В)	Ie	1	МкА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Ic/Ib=(300/10) мА)	Uce	0.2	В
Статический коэффициент передачи тока (Uce=5 В, Ic=300 мА)	h _{21e}	180	
Граничное напряжение (Ie=10 мА)		40	В
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте (Uce=5 В, Ie=300 мА, f=100 МГц)		1.5	

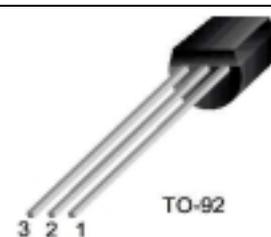
Предельно-допустимые параметры

Параметр	Обозн.	КТ529А КТ530А	Единицы измерения
Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер	Uce max	60	В
Максимальное постоянное напряжение эмиттер-база	Ueb max	4	В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	Ic max	1	А
Рассеиваемая мощность	P max	0.5	Вт
Рабочая температура окружающей среды	Tamb	-60...+85	°С

Розничная цена транзисторов – 3 руб. Цена в партии 100 шт. – 1,98 руб.

pnp
КТ529А
npr
КТ530А

I_c max 1 А
U_c max 60 В
P max 0,5 W



1.база
2.коллектор
3.эмиттер

условная маркировка

КТ529 - ГП
КТ530 - ГН

∇ - товарный знак
изготовителя